

半導体デバイスの静特性測定(2端子)

概要

ダイオード、バリスタ等の2端子半導体デバイスのV-I特性を測定します。ソースメジャーユニットGS610に搭載されたカーブトレサ機能により、汎用ワークシートを利用した特性測定、グラフ描画が可能です。面倒なプログラミングや専用ソフトウェアは一切不要です。

特長

- 汎用ワークシートの利用が可能なカーブトレサ機能
- 従来のカーブトレサに比べ非常に安価(約1/4の価格)
- 最大電圧110V、最大電流3.2Aでのカーブトレサが可能
- 電圧基本確度 $\pm 0.02\%$ 、電流基本確度 $\pm 0.03\%$
- コントロールソフトウェアは不要

